

## 暫定規格

2SA659NP シリコンPNP三重拡散プレーナ型トランジスタ  
低周波小信号増幅一般用

- あらゆる低周波小信号増幅回路一般に応用でき 2SC1175 NP とコンプリメンタリ・ペアが組めます。
- 特に出力15Wまでの低周波電力増幅段の励振用に最適です。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$ 

項目	記号	2SA659NP	単位
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	-50	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	-50	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-200	mA
コレクタ損失	$P_C$	400	mW
接合部温度	$T_j$	125	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	$T_{stg}$	-40 ~ +125	$^\circ\text{C}$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$ 

項目	記号	条件	min.	typ.	max.	単位
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -40\text{V}, I_E = 0$			-10	$\mu\text{A}$
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -3\text{V}, I_C = 0$			-10	$\mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -5\text{mA}, R_{BE} = \infty$	-50			V
直流電流増幅率	$h_{FE}^*$	$V_{CE} = -6\text{V}, I_C = -50\text{mA}$	40	100	320	
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = -6\text{V}, I_C = -10\text{mA}$		90		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -100\text{mA}, I_B = -20\text{mA}$			-1.5	V

\* 2SA659NP は 50mA  $h_{FE}$  によりつぎのように分類しています。

40	C	80	60	D	120	100	E	200	160	F	320
----	---	----	----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

